

日程表 (会場別) 1

北海道工業大学

| 会場 | 収容数 | 9月4日(火) | | 9月5日(水) | | 9月6日(木) | | 9月7日(金) | | 9月8日(土) | | |
|--------------|--------------|---------------|--|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| G棟 | A 1F-G101 | 100 | 13.8 結晶評価、 ナノ不純物・結晶欠陥 | 10.7 生物・医用工学・バイオチップ | 10.7 生物・医用工学・バイオチップ | 10.7 生物・医用工学・バイオチップ | 10.7 生物・医用工学・バイオチップ | 10.7 生物・医用工学・バイオチップ | 10.4 光機能材料・デバイス | 10.4 光機能材料・デバイス | 10.4 光機能材料・デバイス | |
| | B 1F-G102 | 100 | 11.4 配線技術 | 11.4 配線技術 | 11.4 配線技術 | 「フォトリソグラフィ技術の研究開発(超高速/大容量電子制御型波長多重光スイッチードデバイスの開発)」 | 7.8 ビーム応用一般・新技術 | 10.5 液晶 | 10.2 評価・基礎物性 | 10.2 評価・基礎物性 | 10.2 評価・基礎物性 | |
| | C 1F-G103 | 164 | 論文賞受賞式 講演奨励賞贈呈式 | 評議員・代議員 合同会議 | 7.3 リソグラフィ | 「プログラム自己組織化を用いた分子スケールデバイス・ボトムアップ/トップダウン融合の視点から」 | 5.1 半導体レーザー・発光素子 | 「シリコン・フォトリソ技術の最新動向」 | 5.1 半導体レーザー・発光素子 | 5.1 半導体レーザー・発光素子 | 5.1 半導体レーザー・発光素子 | |
| | D 1F-G104 | 191 | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター | | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター | 「M&BE 奨励賞受賞記念講演」 | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター | 「有機デバイスの物性評価と有機FETの新展開(基礎編)」 | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター | 「バイオチップの現状と課題～企業での開発研究の視点から～」 | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター | 10.9 特定テーマA: 有機トランジスター |
| | E 1F-G108 | 84 | 13.5 IV族結晶、 IV-IV族混晶 | 13.5 IV族結晶、 IV-IV族混晶 | 13.2 II-VI族結晶 | 13.2 II-VI族結晶 | 13.7 エピタキシャルの基礎 | 13.3 III-V族エピタキシャル結晶 | 13.3 III-V族エピタキシャル結晶 | 13.3 III-V族エピタキシャル結晶 | | |
| | F 2F-G201 | 104 | フラレン系低次元ナノマテリアル研究の最前線 | | 6.2 カーボン系薄膜 | 6.2 カーボン系薄膜 | 6.2 カーボン系薄膜 | 6.2 カーボン系薄膜 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 |
| | H 2F-G202 | 104 | | 10.6 高分子・ソフトマテリアル | 10.6 高分子・ソフトマテリアル | 「実用化の立場からみたソフトマテリアル」 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 13.3 III-V族エピタキシャル結晶 | |
| | K 2F-G203 | 180 | | 12.4 超高速・機能デバイス | 12.4 超高速・機能デバイス | 「Poly-Si TFT 最近の展開と今後」 | 12.4 超高速・機能デバイス | 12.4 超高速・機能デバイス | | 「ランダム系フォトリソエレクトロニクス研究会「ランダム系材料・デバイスの挑戦、結晶系を超えられるか!？」」 | | |
| | L 2F-G204 | 191 | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 「結晶工学分科会・応用電子物性分科会合同企画「実用化の始まった化合物太陽電池」 | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス |
| | M 2F-G205 | 100 | 14.1 基礎物性・評価 | 14.2 プロセス技術 | 15.7 磁場応用 | 「光と半導体による新しいエネルギー生成と環境浄化」 | 10.1 作製技術 | 10.1 作製技術 | 10.1 作製技術 | 10.1 作製技術 | | |
| | N 2F-G206 | 100 | 12.3 プロセス技術・界面制御 | 12.3 プロセス技術・界面制御 | 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 「電磁場下における様々な現象とその制御-固体金属から流体まで-」 | 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 5.4 光制御 5.5 ファイバー | 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 合同セッションG「量子情報の基礎と応用」 | | |
| | Q 2F-G207 | 84 | 12.1 探索的材料物性 | 12.1 探索的材料物性 | 12.1 探索的材料物性 | 12.1 探索的材料物性 | 5.2 光検出 | 5.3 光記録 | 3.8 近接場光学 | 3.8 近接場光学 | 3.8 近接場光学 | 3.8 近接場光学 |
| | R 3F-G301 | 104 | | 3.4 計測光学 | 3.4 計測光学 | 「微細周期構造をもつ光学素子の新展開」 | 3.3 機器・デバイス光学 | 3.2 材料光学 | 3.3 機器・デバイス光学 4.2 フォトリソナノ構造・現象 | 4.2 フォトリソナノ構造・現象 | | |
| | S 3F-G303 | 180 | | 13.4 III-V窒化物結晶 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | ナノスピントロニクスにおける量子効果と関連現象 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 | 合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 |
| | T 3F-G304 | 191 | 13.6 IV族系化合物 | 13.6 IV族系化合物 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 |
| | V 3F-G305 | 84 | 7.2 電子顕微鏡、 評価、測定、分析 | 7.2 電子顕微鏡、 評価、測定、分析 | 7.1 X線技術 | 7.1 X線技術 | 7.1 X線技術 | 2.2 精密計測・ナノ計測 | 2.1 計測・制御技術 | 2.1 計測・制御技術 2.3 計測標準 | 2.3 計測標準 | 2.3 計測標準 |
| | W 3F-G306 | 100 | 7.6 イオンビーム一般 | 7.6 イオンビーム一般 | 14.1 基礎物性・評価 | 7.4 ナノインプリント | 7.7 微小電子源 | 7.7 微小電子源 | 7.5 ビーム・光励起表面反応 | 7.5 ビーム・光励起表面反応 | | |
| | X 3F-G307 | 84 | 「X線・中性子による quick 反射率法の展望 - 表面や埋もれたナノ構造の変化を追う(III)」 | | 15.1 応用物理一般 | 15.1 応用物理一般 | 14.1 基礎物性・評価 | 3.7 生体・医用光学 3.6 視覚・色彩 | 3.1 物理光学・光学基礎 3.9 光学新領域 | 3.5 情報光学 | | |
| Y 3F-G308 | 84 | 4.7 レーザー・プロセス | 4.7 レーザー・プロセス | 4.7 レーザー・プロセス | 4.7 レーザー・プロセス | 4.4 超高速・高強度レーザー | 4.4 超高速・高強度レーザー | 4.4 超高速・高強度レーザー | 4.4 超高速・高強度レーザー | | | |

日程表 (会場別) 2

北海道工業大学

| 会場 | 収容数 | 9月4日 (火) | | 9月5日 (水) | | 9月6日 (木) | | 9月7日 (金) | | 9月8日 (土) | | |
|---------------|---------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| | | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| G棟 | ZA 3F-G309 | 100 | 1.4 プラズマ応用プロセス | 1.4 プラズマ応用プロセス | 1.7 プラズマエッチング | 「転換期のもの作り人材育成の現状と課題～高校・高专・大学・企業の視点を中心にして～」 | 1.7 プラズマエッチング | JJAP フレンドシップミーティング「目指せ、高被引用数! 英語論文の書き方と新レター論文誌 APEX 創刊」 | 13.1 バルク結晶成長 | 4.6 レーザー分光応用・計測 | | |
| | ZB 4F-G401 | 100 | 1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源 | 1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源 | 1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源 | | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | | |
| | ZC 4F-G402 | 100 | | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | 6.5 表面物理・真空 | 6.5 表面物理・真空 | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | | |
| | ZD 4F-G403 | 84 | 15.5 エネルギー変換・貯蔵 15.6 資源・環境 | 15.3 新技術 15.4 トライボロジー | 1.1 放射線・加速器・原子炉 | 放射線知識普及と活動の最前線 | 1.6 プラズマ現象一般 | 1.6 プラズマ現象一般 | 8.1 磁性材料・磁気デバイス | 8.1 磁性材料・磁気デバイス | 1.3 反応性プラズマの診断と計測 | 1.3 反応性プラズマの診断と計測 |
| | ZE 4F-G404 | 84 | | 9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス | 1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー | 11.6 Si デバイス/集積化技術 | 11.6 Si デバイス/集積化技術 | 「先端 LSI に与える放射線の影響」 「ソフトウェアとハードエラー」 | 11.7 シミュレーション | 11.7 シミュレーション | | |
| | ZF 4F-G405 | 84 | 9.1 基礎物性 | 9.1 基礎物性 | 11.1 基礎物性・評価 | 11.1 基礎物性・評価 | 11.2 半導体表面 | 11.2 半導体表面 | 「活用広がる機能性高密度流体プロセスング」 | | 11.2 半導体表面 | |
| | ZH 4F-G406 | 84 | 9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 | 9.5 アナログ応用および関連技術 | 9.5 アナログ応用および関連技術 | 9.5 アナログ応用および関連技術 | 9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 | 9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 | 9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用 | 9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用 | | |
| ZK 4F-G407 | 84 | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 12.5 半導体光物性・光デバイス | 8.6 新機能材料・新物性 | 8.2 誘電材料・誘電体 | 8.3 微粒子・粉体 | 8.5 熱電変換 | 8.5 熱電変換 | 8.5 熱電変換 | | | |
| 2号館 | ZL 3F-2322 | 180 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 | 「日本学術振興会第 161 委員会企画「半導体バルク結晶技術の現状と展望」」 | 11.6 Si デバイス/集積化技術 | 11.6 Si デバイス/集積化技術 | 11.6 Si デバイス/集積化技術 | 11.6 Si デバイス/集積化技術 |
| | ZM 3F-2323 | 180 | 11.3 絶縁膜技術 | 11.3 絶縁膜技術 | 10.8 有機 EL | 10.8 有機 EL | 11.3 絶縁膜技術 | 11.3 絶縁膜技術 | 11.3 絶縁膜技術 | 11.3 絶縁膜技術 | | |
| | ZN 4F-2401 | 208 | 7.4 ナノインプリント | 「ナノインプリント樹脂材料の開発最前線」 | 13.6 IV 族系化合物 | 「機能デバイスを支えるシリコン結晶基盤技術—次世代 ULSI から環境デバイスまで—」 | 13.6 IV 族系化合物 | 13.6 IV 族系化合物 | 10.3 電子機能材料・デバイス | 10.3 電子機能材料・デバイス | 10.3 電子機能材料・デバイス | |
| | ZQ 5F-2501 | 214 | 6.5 表面物理・真空 | 「薄膜・表面物理分科会企画「ナノスケール構造制御技術の最前線」—ACSI-N-9 プレシジョンボジウム—」 | 11.3 絶縁膜技術 | 「High-k メタルゲートスタックにおける個々のプロセス依存性と制御の現状」 | 「11 半導体 A (シリコン): LSI 多層配線の微細化限界とブレークスルー技術」 | 「11 半導体 A (シリコン): LSI 多層配線の微細化限界とブレークスルー技術」 | 合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 | 「プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演」 「プラズマとその応用プロセスのシミュレーション—現状とさらなる飛躍に向けて—」 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | |
| 5号館 | ZR 1F-5106 | 234 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 「窒化物の新展開」 特定領域研究企画「窒化物光半導体のフロンティア—材料潜在能力の極限発現—」 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 「結晶工学分科会企画シンポジウム「蛍光体結晶でつくる大画面ディスプレイ」と白色 LED の性能改善」 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 「有機デバイスの物性評価と有機 FET の新展開 (応用編)」 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 |
| | ZS 2F-5202 | 180 | | 10.8 有機 EL | 合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 | 10.3 電子機能材料・デバイス | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 13.4 III-V 窒化物結晶 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 |
| | ZT 2F-5203 | 180 | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | | |
| | ZV 3F-3305 | 168 | 第 41 回スクール「スピニエレクトロニクスの基礎—更なる展開と次世代エレクトロニクスデバイスのイノベーションに向けて—」 | | 第 41 回スクール「宇宙環境を利用した科学技術の新展開」 | | 6.1 強誘電体薄膜 | 「14 非晶質・微結晶: 非晶質・微結晶材料における未知物性の開拓」 14.1 基礎物性・評価 | 14.3 デバイス | 「薄膜シリコン太陽電池の新展開」 | 合同セッション D 「プラズマ CVD の基礎と応用」 | |
| 体育館 | ポスターセッション | | 5.4 光制御 11.5 Si プロセス技術 | (前半) 5.4 光制御 9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 (後半) 10.9 特定テーマ A: 有機トランジスタ 10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー | 5.4 光制御 11.5 Si プロセス技術 15.2 教育 | (前半) 7.3 リソグラフィ 合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 (後半) 1.7 プラズマエッチング 10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 11.5 Si プロセス技術 | (前半) 1.7 プラズマエッチング 4.2 フォトニックナノ構造・現象 合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 (後半) 3.3 機器・デバイス光学 10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 6.6 フローブ顕微鏡 8.4 ナノエレクトロニクス | (後半) 3.3 機器・デバイス光学 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 13.1 バルク結晶成長 | | |